PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-337331

(43)Date of publication of application: 07.12.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

(21)Application number : 2000-159597 (22)Date of filing : 30.05.2000

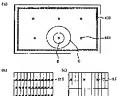
(71)Applicant : TOSHIBA CORP (72)Inventor : OGINO HISAAKI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD

(57)Abstrac

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which can realize reduction of the manufacturing time and has uniform distance between substrates, and its production method, in the liquid crystal display device having a sealing part arranged in a closed frame shape.

SOLUTION: The liquid crystal display device 100 is provided with first and second substrate 200 and 300, a liquid crystal layer 500 arranged between these substrates 200 and 300, a sealing part 400 of a frame shape which is arranged between the substrates 200 and 300, and surrounds a liquid crystal layer 500, and a spacer 213 which maintains the gap between the first and second substrate 200 and 300. The spacer color 13 is formed integrally with at least one substrate of the first and second substrate 200 and 300, and is formed in an ununiform state of substrate 100 and 300, and is formed in an ununiform state of substrate inter-plane density.



(19)日本國特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-337331 (P2001-337331A)

(43)公開日 平成13年12月7日(2001.12.7)

(51) Int.Cl.7		識別配号	FI		テーマコード(参考)
G02F	1/1339	500	G 0 2 F 1/1	339 500	2H089
		5.0.5		505	

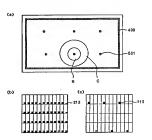
審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出顧番号	特願2000-159597(P2000-159597)	(71)出顧人 000003078
		株式会社東芝
(22) 出願日	平成12年5月30日(2000.5.30)	東京都港区芝浦一丁目1番1号
		(72)発明者 荻野 商明
		兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式:
		社東芝姫路工場內
		(74)代理人 100083161
		弁理士 外川 英明
		Fターム(参考) 2H089 LA09 LA20 NA22 NA42 NA44
		NA45 NA48 QA12 RA05 TA09

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【解決手段】未発明の液晶表示装置100は、第18法 北第2の基板200、300と、これら基板200、3 の間に配置される液晶層500と、前記速程200、 300間に配置される法由層500と、前記速程200、 300間に配置されると共に、前記流品層500を囲む 枠状のシール器400と、前記第1および第2の基板2 の、300の間除を維持するスペーナ213は、前記第1お よび第2の基板200、300の少なくとも一方の基板 一本的に、かつ、基板面に検定を不均一に発成する。



【特許請求の範囲】

【請求項』】 第1および第2の基板と、これら基板間 に配置される流晶層と、前記板板間に配置されると共 に、前記成品層を囲む棒状のシール部と、前記第1およ び第2の基板の間隙を維持するスペーサと、を備えたも 最表示装置であって、前記スペーサは、を備えいまして 第2の基板の少なくとも一方の基板と一体的に、かつ、 基板面内密度を不均一に形皮することを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項2】 前記スペーサの前記第1基板と水平な平面の断面形状が、流線型であることを特徴とした請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 第1および第2の基板と、これら基板間 に配置される液晶層と、前記基板間に配置されると共 に、前記液晶層を囲む枠状のシール部と、前記第1およ び第2の基板の間隙を維持するスペーサと、を備えた液 品表示装置の影音方法において、

前記第1および第2の基板の少なくとも一方の基板に一体的に、かつ基板面内で不均一にスペークを設置すると 共に、少なくも一方の基板にシール材料を塗布する工程と、前記シール材料が塗布された前記一方の基板の前 記シール材料の内部に流晶を流下する工程と、前記5年1 および第2の基板を前記スペーサおよび前記シールが を力して重ね合かせる工程と、前記第1および第2の基板を加圧すると共に前記シール材料を現代することにより、シール部を形成する工程と、を備えたことを特徴とする流晶表表光鏡面の製造方法。

【請求項4】 前記スペーツは、前記成品を流下した位置から遠ざかるほど密度が小さくなるう設置すること を特徴とした前球項3記載の液晶表示装置の製造方法。 【請求項5】 前記スペーツは、前記液品を流下した位置を中心に放射状に分布することを特徴とする請求項3 記載の第6条本蓋の製造方法。

【請求項6】 前記スペーサの基板と平行な断面形状が、流線型であることを特徴とする請求項4および5記載の液晶表示禁管の製造方法。

【請求項7】 前記液晶を滴下する工程において、液晶 は複数箇所に滴下することを特徴とする請求項3記載の 液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[10001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置およびその製造方法に関し、特に、基板間を保持するスペー サを備えた液晶表示装置およびその製造方法に関する。 【0002】

【従来の技術】液晶表示装置に代表される平面表装置 は、薄型、軽量、低消費電力の特徴を活かして各種分野 で利用されている。アクティブマトリクス型の液晶表示 装置を例にとると、アレイ基板と、アレイ基板と対向配 置される対向基板と、これら一対の基板間に保持される 液品層と、一対の基板間に配されると共に、液晶層の周 間に棒杖に配置されるシール部とを備えて構成される。 従来、このような流晶表示装置の製造方法においては、 シール部の一部が開口してなる注入口を有したセルを作 製した後、セル内部を真空排気し、液晶を注入する方法 が一般的であった。しかしながら、このような製造方法 にあっては、セル内部を真空排気する必要からリードタ イムが非常に長く、生産性が損なわれていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】特開平6-19461 5号公解には、枠状のスペーサの外周に位置する枠状の シール材を設けた基板に強強需能品を前下する技術を開 示している。つまり、セルの液晶の注入において、一方 の基板上に溶晶を滴下した後、もう一方の基板を重ねあ かせて流晶セルを作製するもので、一方の基板には一体 的に、均一にスペーサが設けられている。このような製 造方法によれば、従来の裏空排気を不要にでき、この結 電が主によれば、従来の裏空排気を不要にでき、この結 流が下注入方法を更に改善したものであって、基板間距 離が均一で、しかも製造時間の一層の短縮が達成される 流晶表示表載割およびその製造方法を提供することを目的 としている

[0004]

【課題が解決するための手段】請求項1記載の発明は、 第1および第2の基板と、これら基板間に配置される液 品層と、前記基板間に配置されると共に、前記液品層を **用む枠状のシール部と、前記第1および第2の基板の間** 隙を維持するスペーサと、を備えた液晶表示装置であっ て、前記スペーサは、前記第1および第2の基板の少な くとも一方の基板と一体的に、かつ、基板面内密度を不 均一に形成することにある。また、請求項3記載の発明 は、第1および第2の基板と、これら基板間に配置され る液晶層と、前記基板間に配置されると共に、前記液晶 層を囲む枠状のシール部と、前記第1および第2の基板 の間隙を維持するスペーサと、を備えた液晶表示装置の 製造方法において、前記第1および第2の基板の少なく とも一方の基板に一体的に、かつ基板面内で不均一にス ペーサを設置すると共に、少なくとも一方の基板にシー ル材料を塗布する工程と、前記シール材料が塗布された 前記一方の基板の前記シール材料の内部に液晶を滴下す る工程と、前記第1および第2の基板を前記スペーサお よび前記シール材料を介して重ね合わせる工程と、前記 第1および第2の基板を加圧すると共に前記シール材料 を硬化することにより、シール部を形成する工程と、を 備えたことを特徴としている。

【0005】この発明によれば、液晶の注入は滴下注入 を採用し、基板と一体的に形成されたスペーサは、基板 面内で不均一に分布するよう構成されるので、液晶注入 に掛かるリードタイムが大幅に削減され、面内で均一に 液晶を注入できる。 [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明について、図面を参 照して詳細に説明する。図1は液晶表示装置の概略斜視 図、図2は、図1中A-A線に沿って切断した一部概略 断面図である。この実施例の液晶表示装置100は、図 2に示すように、アレイ基板200と、アレイ基板20 0に対向して配置される対向基板300と、これら基板 200.300間に配向膜を介して挟持されるTN(Tw isted Nematic)液晶からなる液晶層500と、基板間 距離を一定に、例えば5.2 mnに保持するアレイ基板 上に一体的に形成されたスペーサ213とを備えて構成 される。また、図1に示すように、2枚の基板200、 300は、表示領域を囲む矩形枠状に配置されたシール 部400により封着されている。アレイ基板200は、 透明絶縁基板201上にほぼ平行に等間隔に配置された 信号線210と、それに層間絶縁層208を介してほぼ 直交して配置された走査線と、それらの交点毎に配置さ れた薄膜トランジスタ (TFT: Thin Film Transistor)及びこれに接続する画素電極2 14から構成されている。以下に詳細な構造を図2を用 いて説明すると、ガラスからなる透明絶縁基板201上 に下地層202を介して配置されたチャネル領域20 7、ソース及びドレイン領域205、206を含むポリ シリコン層と、これらを覆うように形成されたゲート絶 緑膜203と、このゲート絶縁膜203 上に配置された ゲート電極204とから、コプラナ型ポリシリコンTF Tが構成されている。そして、ゲート絶縁膜203およ び層間絶縁層208に形成されたコンタクトホールを介 してソース及びドレイン領域205、206に電気的に 接続されるソース電極209及び信号線210が配置さ れている。また、この上には、絶縁層211を介して、 R、G、Bの着色層212が形成され、この着色層21 2 LCHITO (Indium Tin Oxide) からなる画素電極214が配置され、この画素電極21 4は絶縁層211及び着色層212に形成されたコンタ クトホールを介してソース電極209と電気的に接続さ れている。そして着色層212上の画素電極間の領域に は柱状スペーサ213が形成され、柱状スペーサ21 3. 画素電板214. 着色層212を覆うように基板全 面に配向膜215が設けられている。

【0007】一方、アレイ基板200に対向配置される 対向基板300は、対向電板302と、配向膜303と が透明静線基板301上に配置されて構成される。次 に、アレイ基板200上に形成された柱状スペーサ21 3について詳しく説明する。図3(a)はアレイ基板の板 毎平面図、図3(b)は同図(a)中円で間まれる領域の拡 大図、図3(c)は同図(a)中円で間まれる領域の拡 大図、医3、は、世界で、中間、シール内で均一 に、大気圧を支えるに大使、必要扱小限の範囲、例3 2000~3000μm²/mm²で配置されていた。 これに対して、この実施例では、柱状スペーサ213の 配置は、図3に示す場り、総画面下位置501付近では 高密度、4000μm2/mm2に、液晶高下位置50 1より遠芒かるにつれ、密度簿、1000μm2/mm に形破され、基板両内位置によって、異なる密度で柱 状スペーサ213が設置される。このように、柱状スペーサ213を不助一に、液晶の広がり遠度に合わせて最 遊を条件で柱状スペーサを設置する。また、柱状スペー サ213は、アレイ基板200と平行で新雨形状が流線 で、高さ5、2μmの柱状である。そして楕円形状の状 で、高さ5、2μmの柱状である。そして楕円形状の長 軸が高庁位置501を中心として略放射線状に配置される。

【0008】このように面内密度の異なる柱状スペーサ 213を、滴下位置501から遠ざかるにつれて密度薄 に放射状に配置することにより、特に、基板周辺での液 晶の広がり速度の低下が防止され、これにより一層の短 時間で均一な注入が達成できる。また、柱状スペーサ2 13の断面形状は、上記形状に限定されるものではな く、液晶が広がる際にその動きを阻害しない形状であれ ばよい、例えば図4に、柱状スペーサの断面形状の例を 示す。 図4 (c) は楕円形で、本実施例のものである。 他の断面形状としては、図4(c)の楕円形を変形させ て、(a)や(b)のような流線形状であったり、(d) の四角形、(e)の六角形などの多角形であってもよい。 また、(f)のように曲率円の一部を直方体を介して対 向させた流線形状としてもよい。いずれの場合も、液晶 に対してその広がり方向を阻害しないような形状となっ ている。このように、本発明では、スペーサの断面形状 を流線形状とすることにより、液晶注入ムラのない、表 示品位の良好な液晶表示装置が得られる。また、スペー サをアレイ基板と一体的に形成するため、液晶の広がり に対して、スペーサが移動することなく、優れた面内基 板間隔の均一性が図れ、製造歩留まりの向上、長期間に 渡り優れた信頼性を確保することができる。

【009】このような、スペーサ213は、次のようにして形成する。基板上の全体に、ここでは着色層212上全面に、黒レジストをスピンナを用いて塗布し、80℃、2分で乾燥後、所定のフォトマスクを用いて、終長365m。 職光量 250 mJ/cm² で第光する。この後、p相1.707MM (tri methyl amonium hydride) 水溶液にて厚さ5.2 μmで、高さの均一なスペーサが形成 広に厚さ5.2 μmで、高さの均一なスペーサが形成 される。次に、巻色層 21 2 及び絶縁層 21 1 に形成された側口を介してソース電極 20 9 に接続する画業電極 21 4 を形成した後、柱状スペーサ213、画業電極 21 4 米 着色層 21 2 を覆えらこに配り頗215を設け、アレイ基板200を形成する。一方、対向基板300 に向腹303を腕が振301上に対向電板300 に向腹303を腕が振301上に対向電板300 に向腹303を腕が形成してなる。その後、図1のよう

に、紫外線硬化するシール材料をディスペンサーまたは マスクパターンを用いて配的処理の終わったアレイ基板 200上に塗布する。この時、シール材料は表示領域の 外間に沿って、枠状、ここでは矩形状に開口のない閉じ た系で塗布される。

【0010】次に、シール材料を連布した基板200に セル体積と同量の液晶を複数箇所に滴下し、対向基板3 00重独自をわせる。2枚の基板200、300の位置 を正確に位置あわせし、紫外線光を照射し、2枚の基板 200、300が打なかように仮止を行う。このよう な重ね合わせ工程は約1330hの真空中で実施する。 従って、たとえセル内に気治が発生したとしても真空治 ため、この後の工程の雨能のデールにで敷すると ができる。仮止めを実施した2枚のガラス基板20 0、300を所望の基板間隔を保持するようアレスを大 気中行い、紫外線光を照射し、シール材料を硬化させ、 シール部400を形成する。真空中で重ね合わせたセル を、大気中に配置することにより、大気圧により1kg f/cm²にてアレスする。プレス時に往必要に応じ

て、加圧してもよく、対向基板300により押しつよさ れて、広がった液晶が均一に分布した液晶表で表置10 0が形成される。つまり、液晶高下位置付近では、液晶 は早い速度で広がり、液晶高下位置から速さかるにつれ て、広がり速度は遅くなるが、液晶高下位から速い位 置ではスペーサが密度薄に形成し、液晶の広がり速度を 調整することで、液晶の注入ムラを抑制し、表示品位に 優れた液晶表示機器が疾程をよる。

【0011】また、このようを製造方法により、装置コ ストを抑え、製造に掛かるリードタイムを大幅に削減す ることができる。上述の実施排物では、アレイ基板20 0上にスペーサ213が国定配置され、かつシール材料は各 マアレイ基板1、対向基板しかいずれか一方に配置或い は途布されてが、スペーサ213およびシール材料は各 マアレイ基板1、対向基板しかいずれか一方に配置或い は途布されてもよい。例えば、2枚の基板の一方にスペ ーサを配置し、他方にシール材料を並布してもよく、 に限定されてい。また、シール材料として、繋り線硬化 するものを用いたが、熱硬化するものを用いても良く、 この場合は、加圧・加熱することにより硬化すればよ い、また、上述の実施形態では、2 位の透明性験差板に 表示用パターンとして対向電極、画業電極をそれぞれ形 成した施品券示装置を用いたが、IPS (In PlaneSultch 同別 モードのように一方の基板に表示用電管パターン として対向電板、画業電極を配置した流品表示装置にも 適用できる。また、上述の実施形態では、IPTの半導体 層にポリシリコンを用いて説明したが、半導体層として アモルファスシリコンを使ったIPTでもよく、例えば逆 スタケ西学者、その雑造も原金されない。

[0012]

【発明の効果】この発明によれば、面内密度を不均一に 配置したスペーサを基板と一体的に形成することによ り、生産性が向上され、また表示品位に優れた液晶表示 装蓄が得られる。

【図画の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の一実施例の液晶表示装置の概 略斜視図である。

【図2】図2は、図1中A-A線に沿って切断した一部概略断面図である。

【図3】図3は、本発明のアレイ基板を図示したものであり、同図(a)は略平面図、図(b)は図(a)中円8で囲まれた領域の一部を拡大した一部拡大略平面図であり、図(c)は図(a)中領域の一部を拡大した一部拡大略平面図である。

【図4】図4(a) \sim (f)は、本発明の個々のスペーサを基板と平行な面で切断した断面図である。

【符号の説明】

100・・・液晶表示装置

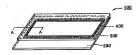
200・・・アレイ基板 300・・・対向基板

300···対向基板 500···液品層

400・・・シール部

材料を塗布してもよく、特 213・・・スペーサ ルはポレーア 夢外紋硬ル





[図4]



